## テラヘルツ共鳴トンネルダイオードとフォトニック結晶導波路の集積化 と通信応用

Integration of Resonant Tunneling Diodes with Photonic Crystal Waveguide for Terahertz Communications

## 阪大基礎工<sup>1</sup>, ローム<sup>2</sup> <sup>0</sup>兪 熊斌<sup>1</sup>, 山田 諒明<sup>1</sup>, 金 在瑛<sup>2</sup>, 冨士田 誠之<sup>1</sup>, 永妻 忠夫<sup>1</sup>

## Osaka Univ.<sup>1</sup>, Rohm Co., Ltd.<sup>2</sup> X. Yu<sup>1</sup>, R. Yamada<sup>1</sup>, J. Kim<sup>2</sup>, M. Fujita<sup>1</sup>, T. Nagatsuma<sup>1</sup>

E-mail: fujita@ee.es.osaka-u.ac.jp, u787204k@ecs.osaka-u.ac.jp

光波と電波の間の周波数を有するテラヘルツ電 磁波は、高速無線通信などの応用が期待されてい る.しかしながら、テラヘルツ帯はフォトニクス とエレクトロニクスの極限領域に位置するため、 そのデバイス技術は発展途上である.我々は、テ ラヘルツデバイスの集積化に向けて、2次元フォ トニック結晶(Photonic Crystal: PC)スラブに着目し、 0.1 dB/cm 以下という極低損失なテラヘルツ導波 路を実現してきた[1].一方、テラヘルツ帯の小型 能動素子として、共鳴トンネルダイオード (Resonant Tunneling Diode: RTD)[2]が有望である.

前回, PC 導波路と RTD の高効率結合と広帯域動 作に向けて, PC 導波路と金属線路の高効率結合に 関する検討を行い,最大結合効率 67%,3 dB 帯域 70 GHz という高効率かつ広帯域な結合構造の設 計について報告した[3].

今回, 設計した結合構造に基づき, PC 導波路の 両端に RTD を集積化したデバイスを作製し, それ ぞれの RTD を送信器(Tx)および受信器(Rx)として, 導波路間の通信実験を行ったので報告する.

図1に作製した集積デバイスの写真とRTDチッ プの寸法図を示す. PC 導波路は 0.3 THz 帯に動作 帯域を有する厚さ 200 µm の Si 基板に周期 240 µm の円孔三角格子を形成し、孔を線欠陥状に埋めた 構造である.線欠陥導波路の両端部分には、別途 作製する RTD をハイブリッド集積化するための 長さ830 µm,幅272 µmの溝を形成した.一方, 厚さ 100 μm の InP 基板上に RTD 構造と金属線路 および metal-insulator-metal (MIM)キャパシタ構造 を形成し、電界強度の強い導波路のスラブ中心と RTD の高さを一致させるように前述の溝に埋め込 んだ. ここで, スロット幅 6 µm のコプレーナスト リップ線路中に RTD を設置し, RTD と MIM キャ パシタの距離を 20 µm とした共振回路を形成し, 0.34 THz 帯での発振が得られるようにした. さら に、線路のスロット幅を260µmまで広げる指数関 数的な形状を有するテーパ構造によって, PC 導波 路の電磁界を断熱的に変化させることで高効率か つ広帯域な PC 導波路と RTD の結合を実現した.

MIM キャパシタはテラヘルツ波と 20 GHz 以下の ベースバンド信号を分離するローパスフィルタの 役割も果たし、コプレーナストリップ線路端に形 成した電極パッドを通じて、RTD ヘバイアス電圧 および変調信号を印加することができる.

試作したデバイスにプローブを用いてバイアス 電圧を印加することで図1左側のRTDを発振動作 させ,ON-OFF 変調を行った.一方,図1右側の RTDを検出器として動作させ,プローバを通じて, アイパターンと通信速度に対するビットエラーレ ートを測定した.図2に示すように9Gbit/sにお いて明瞭なアイパターンが観測され,通信速度が 9Gbit/s以下で,10<sup>-11</sup>以下のビット誤り率(エラー フリーの動作)が得られた.

**謝辞**:本研究の一部は,JST CREST(#JPMJCR1534) の支援を受けた.

## 参考文献

- [1] K. Tsuruda et al. Opt. Express, 23 (2015) 31977.
- [2] S. Diebold et al. Electron. Lett., **52** (2016) 1999.
- [3] 兪他, 秋季応物学会 (2017) 8a-S21-8.





